

1. Асадчиков В.Е., Мчедlishvili Б. В., Пономарев Ю.В., Постнов А.А., Сенин Р.А., Цыганова Т.В.. «Рентгеновская микроскопия с использованием асимметричного отражения от монокристалла». Письма в ЖЭТ, 2001, т.73, вьт.4, сс.205 - 209.
2. А.В.Андреев, В.Е.Асадчиков, И.А.Артюков, А.В.Виноградов, В.Н.Зрюев, Ю.С.Касьянов, В.В.Кондратенко, В.Е.Левашов, Б.В.Мчедlishvili, Ю.В.Пономарев, А.В.Попов, А.А.Постнов, С.В.Савельев, Р.А.Сенин, И.И.Струк. «Рентгеновская микроскопия трековых мембран и биологических объектов в мягком и жестком диапазонах длин волн». Кристаллография, 2001, т.46, №4, сс.658-663.
3. В.Е.Асадчиков, А.В.Виноградов, В.Н.Зрюев, И.В.Кожевников, Ю.С.Кривоносов, Р.Мерсье, И.Намба, С.И.Сагитов, М.Ямомото. «Метод рентгеновского рассеяния в изучении процесса полировки сверхгладких подложек». Заводская лаборатория (диагностика материалов), 2001, т.67, № 67, ее. 19 - 23.
4. Asadchikov V.E., Bukreeva I.N., Duparre A, Kozhevnikov I. V., Krivonosov Y. S., Morawe C, Pyatakhin M.V., Steinert J., Vinogradov A.V., Ziegler E. "X-ray study of surfaces and interfaces". Proc. SPIE, 2001, V. 4449, p. 253 - 264.
5. Asadchikov V. E. et al. Structure and properties of "nematically ordered" aerogels //JETP letters. – 2015. – Т. 101. – С. 556-561.
6. Asadchikov V. E. et al. Microstructure of Si Crystals Subjected to Irradiation with High-Energy H+ Ions and Heat Treatment by High-Resolution Three-Crystal X-Ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy //Physics of the Solid State. – 2019. – Т. 61. – С. 1707-1715.
7. Zolotov D. A. et al. New approaches to three-dimensional dislocation reconstruction in silicon from X-ray topo-tomography data //Uspekhi Fizicheskikh Nauk. – 2023. – Т. 193. – №. 9. – С. 1001-1009.
8. Asadchikov V. E. et al. Correcting the characteristics of silicon photodiodes by ion implantation //Semiconductors. – 2020. – Т. 54. – С. 666-671.
9. Asadchikov V. E. et al. X-ray diagnostics of microstructure defects of silicon crystals irradiated by hydrogen ions //Technical Physics. – 2019. – Т. 64. – С. 680-685.
10. Zolotov D. A. et al. Unusual X-Shaped Defects in the Silicon Single Crystal Subjected to Four-Point Bending //JETP Letters. – 2021. – Т. 113. – №. 3. – С. 149-154.